

⑨ 日本国特許庁(J P)

⑩ 特許出願公開

⑧ 公開特許公報(A)

昭62-279625

⑪ Int. Cl.

H 01 L 21/205

識別記号

庁内整理番号

7739-5F

⑬ 公開

昭和62年(1987)12月4日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 エピタキシャル成長法

⑮ 特 願 昭61-122984

⑯ 出 願 昭61(1986)5月28日

⑰ 発 明 者 星 妙 子 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内
 ⑱ 発 明 者 林 久 雄 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内
 ⑲ 出 願 人 ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号
 ⑳ 代 理 人 弁理士 伊 藤 貞 外1名

明 細 書

発明の名称 エピタキシャル成長法

特許請求の範囲

ジシランを反応ガスとして用いて半導体基板表面の自然酸化膜を除去する工程と、

その後上記半導体基板表面に単結晶層をエピタキシャル成長する工程と、

上記自然酸化膜の除去工程と、上記単結晶層のエピタキシャル成長工程との間に上記反応ガスのジシランを排除する工程とを有することを特徴とするエピタキシャル成長法。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体基板上に半導体単結晶層を成長形成するエピタキシャル成長法に係わる。

(発明の概要)

本発明は、半導体基板上に単結晶層をエピタキシャル成長するに先立って、特に反応ガスとしてジシラン Si_2H_4 ガスをを用いて半導体基板表面の自

然酸化膜の除去を行い、その後特にこのジシランを排除した工程を経て後に、単結晶層のエピタキシャル成長を行うものであり、このようにすることによって結晶性にすぐれた単結晶層の形成を可能にするものである。

(従来の技術)

シリコン(Si)単結晶半導体基板上に、例えばSi単結晶層をエピタキシャル成長する場合、通常その単結晶層の形成に先立って半導体基板表面の自然酸化膜を除去する前処理が行われる。この前処理は、半導体基板が配置される反応容器内に水素ガスを送り込みつつ第2図にその温度プログラミングを示すように、加熱を行い、基板温度を例えば1050~1150℃程度に高温加熱し、この状態で H_2 ガス中或いは HCN ガス供給下で所定時間A、例えば10分間の高温処理を行うことによって自然酸化膜の除去処理を行う。その後、基板温度を例えば700~900℃に下げ例えばモノシラン SiH_4 をキャリアガス H_2 と共に送り込んでSiのエピタ

キシャル成長を行うことが一般に行われている。

ところが、近時半導体基板の大酸化がとみに進み、上述した前処理に際しての高温処理による基板の反り（そり）の発生が問題となって来ている。また、このような高温処理を行うことは例えば基板の不純物のオートドーピング等の問題がある。

一方、Si層のエピタキシャル成長を、ジシラン Si_2H_6 ：ガスをを用いた 900℃程度の加熱によって行うことの試みがなされている。この場合の温度プログラミングは、第3図に示すように、例えば 900℃程度の一定の加熱による区間Cを設けてそのエピタキシャル成長を行うものである。この場合、前処理のための特別の作業は行われない。これは Si_2H_6 が比較的活性に富み、その熱分解によって生じた水素ガスが、基板表面の自然酸化膜 SiO_2 と反応してこれを排除するエッチング反応工程を含むためと思われるが、この方法による場合、エピタキシャルされたSi層に結晶欠陥が生じ易く、信頼性に問題がある。これは、原料ガスのジシラン Si_2H_6 ：ガス自体がモノシラン SiH_4 ：ガス

に比し純度が低いということもさることながら、 Si_2H_6 ：によるエピタキシャル成長を行う場合、上述した SiO_2 のエッチング作用と同時に SiO_2 ：+ Si → 2SiO の反応も生じ、この SiO の一部がキャリアガスと共に排除されずにエピタキシャル成長膜中に取り込まれるとか基板からエッチングによってとり出された各種不純物がエピタキシャル成長膜中に取り込まれて結晶欠陥の発生原因を形成するものと考えられる。

（発明が解決しようとする問題点）

本発明は、上述したような高温加熱を伴う前処理を回避して、大径の半導体基板における反りの問題の解消若しくは減少をはかり、しかもエピタキシャル成長膜の結晶性の問題の解消をはかる。

（問題点を解決するための手段）

本発明においては、Si半導体基板表面の自然酸化膜の除去工程を、特にジシラン Si_2H_6 ：によって行う。次にSi結晶層のエピタキシャル成長を行

うものであるが、特に本発明においては、上述の自然酸化膜除去工程後とエピタキシャル成長工程との間に、反応容器中の上述のジシランを一旦排除する工程を挿入する。つまり、エピタキシャル成長を行わんとするSi半導体基板を収容配置した反応容器内で Si_2H_6 ：によって比較的低い基板温度 800～1000℃での熱処理によって基板表面の自然酸化膜のエッチング除去を行って後に、反応容器内の雰囲気例えばキャリアガスの H_2 ：ガスのみの供給によって SiH_4 ：を排除する。

そして、その後モノシラン SiH_4 ：、或いはジシラン Si_2H_6 ：等の原料ガスをキャリアガスと共に送り込んで通常のSiエピタキシーを行う。

（作用）

上述の本発明方法によって得たSiエピタキシャル層は、良好な結晶性を有することが確められた。これは上述したように、本発明においては、エピタキシーの前処理として、半導体基板表面の自然酸化膜のエッチング除去を行って後にエピタキ

シーを行っていることによって、良好なエピタキシャル成長を行うことができることと、自然酸化膜除去の前処理の後に一旦 Si_2H_6 ：の排除を行ったことによってエッチング時に生成されたり基板からとり出された SiO 等の不要物質、不純物等が取り去られ、この SiO がエピタキシャル成長膜中にとり込まれることが回避されたことによるものであると考えられる。そして、更に、このエピタキシャル工程で、モノシラン SiH_4 ：を原料ガスとするSiのエピタキシャル成長を行う場合は、この原料ガスとして純度の高いものが得られるので、よりすぐれたエピタキシャル層の生成を行うことができる。

（実施例）

本発明によるエピタキシャル成長法の一例を第1図のプログラミング図を参照して説明する。この例においては、シリコン結晶半導体基板を収容配置した反応容器内にキャリアガス H_2 ：と共に Si_2H_6 ：を送り込み、基板温度を 900～950℃に

熱してD区間例えば10分間熱処理して基板表面の自然酸化膜を除去する。その後反応容器内に例えばキャリアガスH₂のみを送り込んで第1図のE区間でSi₃H₈ガスを供給する。

そして、例えばこのままの加熱温度で、すなわち、第1図に実線で示した基板温度の状態で反応容器内にモノシラン SiH₄を供給しF区間、例えば10~30分間でSi層をエピタキシャル成長する。

尚、第1図、実線図示の例では、前処理とエピタキシャル成長とはほぼ同一温度下で行った場合であるが、同図破線で示すように、エピタキシャル工程での基板温度を800℃程度に下げてジシラン Si₂H₆によるエピタキシャル成長を行うこともできるし、そのエピタキシャル成長は、従来公知の種々の方法を選び得る。

(発明の効果)

上述したように本発明によれば、Si層のエピタキシャル成長に先立って、半導体基板表面の自然酸化膜をエッチング除去する前処理を行うもので

あるが、特にこの処理をSiH₄によって行うようにしたのでその処理温度は比較的低温で行うことができる。したがって、半導体基板がこの熱処理によって反るなどの彎曲の発生を回避でき、これに伴う歪の発生や、各種半導体装置の製造工程、例えばフォトリソグラフィ工程等における基板の彎曲に基づく誤差の発生、ひいては不良品の発生を回避でき、大口径半導体ウエハに適用して、特に大きな利点をもたらすものであり、またオートドーピングの低減化などの利点をもたらす。

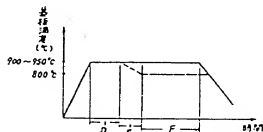
また、この前処理の後に、Si₃H₈の供給を行うようにしたので、前処理に際して生成されたSiO₂や基板からとり出された不純物B、As、P等のエピタキシャル膜へのとり込みを回避でき、結晶性にすぐれたSiのエピタキシャル成長膜を形成できる。

上述したように本発明によれば、半導体基板の彎曲の発生を回避し、良質なエピタキシャル膜の形成を可能にするので、集積回路、単体半導体装置等の各種半導体装置の製造に適用してその利益

は極めて大なるものである。

図面の簡単な説明

第1図は本発明によりエピタキシャル成長法の温度プログラミング図、第2図及び第3図は夫々従来方法の温度プログラミング図である。

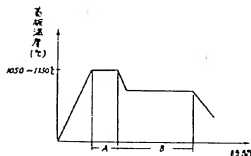


本発明によるエピタキシャル成長法の温度プログラミング図

第1図

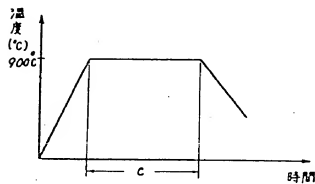
代理人 伊 藤 貞

同 松 岡 秀 彦



従来法の温度プログラミング図

第2図



SizH₆によるエピタキシャル成長の
温度プログラミング図

第 3 図